

产品概览

FDD10N20LZ: 功率 MOSFET , N 沟道 , 逻辑电平 , UniFET™ , 200 V , 7.6 A , 360 mΩ , DPAK

欲看完整文档, 请参阅数据表。

UniFET™ MOSFET 是基于平面条纹和 DMOS 技术的高压 MOSFET 系列。此 MOSFET 适用于降低导通电阻, 提供更好的开关性能以及更高的雪崩能量强度。此器件系列适用于开关电源转换器应用, 如功率因数校正 (PFC)、平板显示屏 (FPD) TV 电源、ATX 和电子灯镇流器。

特性

- $R_{DS(on)} = 300\text{m}\Omega$ (典型值) @ $V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 3.8\text{A}$
- 低栅极电荷 (典型值 12nC)
- 低 C_{rss} (典型值 11pF)
- 100% 经过雪崩击穿测试
- 提高了 dv/dt 处理能力
- 改进了 ESD 防护能力
- 符合 RoHS 标准

应用

- This product is general usage and suitable for many different applications.

器件电气规格

| 产品 | Pricing (\$/Unit) | Compliance | Status | Channel Polarity | Configuration | $V_{DS(BR)}$ Min (V) | V_{GS} Max (V) | $V_{GS(th)}$ Max (V) | I_D Max (A) | P_D Max (W) | $R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5\text{V}$ (mΩ) | $R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5\text{V}$ (mΩ) | $R_{DS(on)}$ Max @ $V_{GS} = 10\text{V}$ (mΩ) | Q_3 Typ @ $V_{GS} = 4.5\text{V}$ (nC) | Q_3 Typ @ $V_{GS} = 10\text{V}$ (nC) | C_{iss} Typ (pF) | Package Type |
|--------------|-------------------|------------------------|--------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|--|---|---|--|-----------------------|-------------------|
| FDD10N20LZTM | 0.3185 | Pb-free Halide free | Active | N-Channel | Single | 200 | ±20 | 3 | 7.6 | 83 | - | 400 | 360 | - | 12 | 440 | DPAK-3 / TO-252-3 |

欲了解更多信息, 请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于: 4/8/2020